

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные $p-n-p$ маломощные

Предназначены для работы в усилительных и импульсных микромодулях и блоках герметизированной аппаратуры

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами в двух вариантах

Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 0,3 г

Пределенные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

при $T = 298 - 373$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В	15 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	30 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К	45 В
КТ209Л, КТ209М	60 В

при $T = 228$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В	10 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	25 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К	40 В
КТ209Л, КТ209М	55 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{BE} \leq 10$ кОм

при $T = 298 - 373$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В	15 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	30 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К	45 В
КТ209Л, КТ209М	60 В

при $T = 228$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В	10 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	25 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К	40 В
КТ209Л, КТ209М	55 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:

при $T = 298 - 373$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	10 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М	20 В

при $T = 228$ К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е	10 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М	15 В

Постоянный ток коллектора 300 мА

Импульсный ток коллектора 500 мА

Постоянный ток базы 100 мА

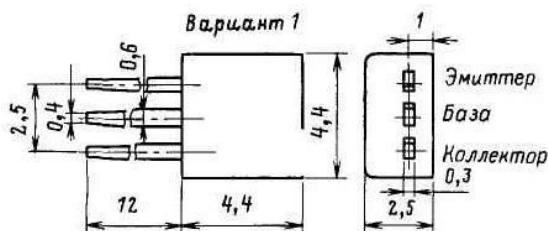
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 200 мВт

Тепловое сопротивление переход-среда 0,45 К/мВт

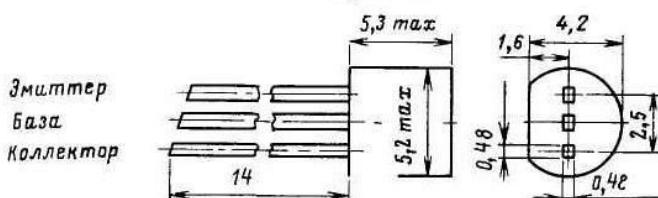
Температура перехода 398 К

Температура окружающей среды От 228

до 373 К



Вариант 2



Электрические параметры

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KE} = 5$ В, $I_K = 10$ мА не менее 5 МГц

Коэффициент шума при $U_{KE} = 3$ В, $I_K = 0,2$ мА, $f = 1$ кГц, $R_t = 3$ кОм КТ209В, КТ209Е, КТ209К не более 5 дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KE} = 1$ В, $I_K = 30$ мА при $T = 298$ К 20 - 60

КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л 20 - 60

КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М 40 - 120

КТ209В, КТ209Е 80 - 240

КТ209К 80 - 160

при $T = 373$ К 20 - 120

КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л 20 - 120

КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М 40 - 240

КТ209В, КТ209Е 80 - 480

КТ209К 80 - 320

при $T = 228$ К 10 - 60

КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л 10 - 60

КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М 20 - 120

КТ209В, КТ209Е 40 - 240

КТ209К 40 - 160

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 300$ мА, $I_B = 30$ мА не более 0,4 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 300$ мА, $I_B = 30$ мА не более 1,5 В

Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 10$ В, $f = 500$ кГц не более 50 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB} = 0,5$ В, $f = 1$ МГц не более 100 пФ

Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером* при $U_{KE} = 5$ В, $I_K = 5$ мА 130 - 2500 Ом

Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = U_{EB\max}$ не более 1 мкА